APCSCRM เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์

ชวนนักวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนเอกสารทางเทคนิค

การประชุม APCSCRM ซึ่งเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2018 ขอเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญในเอเชียแปซิฟิกมาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์แบบ wide bandgap การเตรียมอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ และการใช้โมดูลอุปกรณ์ โดยรายนามส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมมีดังนี้

ลำดับ
ชื่อ
หัวข้อรายงาน
1
Manabu ARAI (บริษัท New JRC, ญี่ปุ่น)
Comprehensive Review of Widebandgap Semiconductor Devices

2
Hsien-Chin CHIU (มหาวิทยาลัย Chang Gung University, ไต้หวัน)

Package and Module Development of Six-inch Silicon-based GaN Power and Microwave Devices

3
Andy CHUANG (บริษัท Episil Technologies Inc., ไต้หวัน)

SiC Foundry Introduction from Episil

4
Yasuto HIJIKATA (มหาวิทยาลัย Saitama University, ญี่ปุ่น)

A Macroscopic Simulation of the SiC Thermal Oxidation Process based on the Si and C Emission Model

5
Noriyuki IWAMURO (มหาวิทยาลัย University of Tsukuba, ญี่ปุ่น)

Recent progress of SiC MOSFET Devices

6

Guoyou LIU (บริษัท Zhuzhou CRRC Times Electric Co.,Ltd., จีน)

The Application Prospect of SiC Devices in Rail Transit

7

Hideharu MATSUURA (มหาวิทยาลัย Osaka Electro-Communication University, ญี่ปุ่น)

Electrical Characterizationof Wide Band-Gap Semiconductors Using Hall-effect Measurements

8

Tokuyasu MIZUHARA (บริษัท ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd., ญี่ปุ่น)

Market Applications of Power Devices (SiC) ~ Characteristics and Applications of SiC Power Devices

9

Yufeng QIU (สถาบัน Global Energy Internet Institute, จีน)

The Application of SiC Devices into Future Power Grid

10

Guosheng SUN (บริษัท Dongguan Tianyu Semiconductor Technology Co. Ltd. และสถาบัน Institute of Semiconductors, CAS, , จีน)

Review of Structures and Origins of Triangular-shaped Defects in 4H-SiC

11

Xuhui WEN (สถาบัน Institute of Electrical Engineering, CAS, จีน)

Technical Approaches towards Ultra-high Power Density SiC Inverter in Electric Vehicle Applications

12

Q. Jon ZHANG (มหาวิทยาลัย North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา)

Current Status and Future Perspectives of Wide Bandgap Semiconductor Devices and Applications

นอกจากนี้ APCSCRM ยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์แบบ wide bandgap อุปกรณ์ และการใช้งาน โดยเปิดรับเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพในด้านนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการส่งเอกสาร

1. ส่งร่างเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ APCSCRM (ดูวิธีการได้ที่ http://www.apcscrm2018.iawbs.com ใต้หัวข้อ submission)
2. ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2018
3. ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2018

4. กรุณาตรวจสอบสถานะการพิจารณาเอกสาร (ทางระบบส่งเอกสารออนไลน์ของ APCSCRM)